

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【公開番号】特開2006-196650(P2006-196650A)

【公開日】平成18年7月27日(2006.7.27)

【年通号数】公開・登録公報2006-029

【出願番号】特願2005-6232(P2005-6232)

【国際特許分類】

H 01 L 21/8247 (2006.01)

H 01 L 27/115 (2006.01)

H 01 L 35/28 (2006.01)

H 01 L 29/792 (2006.01)

H 01 L 29/788 (2006.01)

【F I】

H 01 L 27/10 4 3 4

H 01 L 35/28 Z

H 01 L 29/78 3 7 1

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月15日(2007.5.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

電荷保持部とこの電荷保持部に隣接する絶縁部とを有すると共に上記電荷保持部に電荷を保持させることによって情報を記憶する半導体不揮発性メモリと、

上記半導体不揮発性メモリに対してアニール処理を行うアニール部とを備え、

上記アニール部は上記半導体不揮発性メモリの近傍に設置されていることを特徴とする半導体不揮発性メモリ装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

上記課題を解決するため、この発明の半導体不揮発性メモリ装置は、電荷保持部とこの電荷保持部に隣接する絶縁部とを有すると共に上記電荷保持部に電荷を保持させることによって情報を記憶する半導体不揮発性メモリと、

上記半導体不揮発性メモリに対してアニール処理を行うアニール部とを備え、

上記アニール部は上記半導体不揮発性メモリの近傍に設置されていることを特徴としている。